

关键指标

频率：9~10GHz
功率增益：17dB
输出功率：41dBm
功率附加效率：40%
二次/三次谐波：-25dBc
工作电压：Vdd: +28V, Vgg: -2.4V
产品尺寸：15.2mm×10.7mm

产品简介

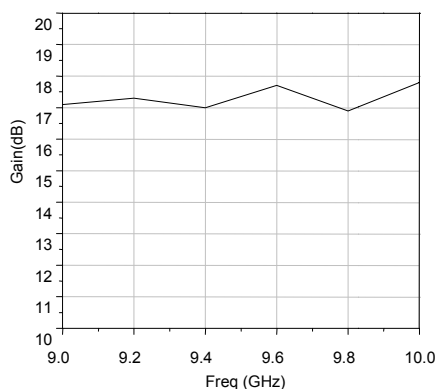
HG535F 是一款 9~10GHz 内匹配功放管，采用 GaN HEMT 工艺制作，功率增益为 17dB，输出功率为 41Bm，功率附加效率为 40%。

电性能（栅压-2.7V，漏压+28V，静态电流：50mA，脉宽 100us，周期 300us，33.3%占空比）

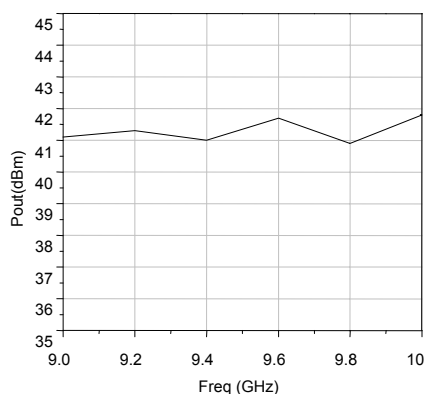
指标	最小值	典型值	最大值
频率(GHz)	9~10		
功率增益(dB)	—	17	—
增益平坦度(dB)	—	±0.5	—
输出功率(dBm)	—	41	—
功率附加效率(%)	—	40	—
二次/三次谐波(dBc)	—	-25	—

典型测试曲线

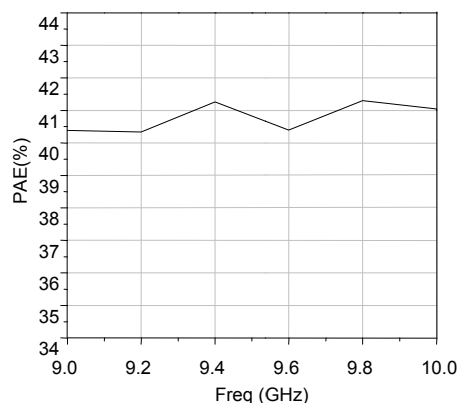
功率增益



输出功率



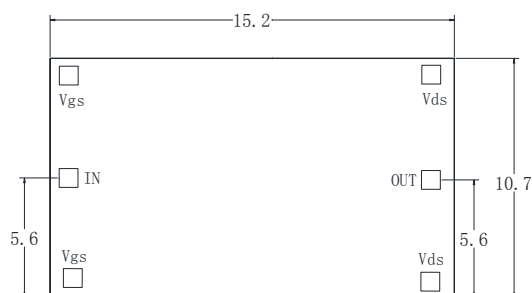
功率附加效率



绝对额定最大值

工作电压	+36V
最大输入功率	+20dBm
工作温度	-55℃~85℃
存储温度	-65℃~150℃

外形和端口尺寸 (mm)



注意事项

1. 功放管在干燥、氮气环境中存储，在超净环境使用；
2. 功放管管脚硬度低，外力扭曲容易断裂，使用时必须小心；
3. 功放管栅极、漏极馈电线需焊接 10uF 去耦电容，去耦电容耐压值≥50V；
4. 功放管对静电敏感，在储存和使用过程中注意防静电。